【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成19年1月25日(2007.1.25)

【公開番号】特開2001-168395(P2001-168395A)
【公開日】平成13年6月22日(2001.6.22)
【出願番号】特願平11-349627
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　33/00　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　33/00　　Ｅ
Ｈ０１Ｌ　33/00　　Ｂ
Ｈ０１Ｌ　33/00　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成18年11月30日(2006.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体層からなる発光部、酸化物からなる窓層、結線用台座電極を備えたＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体発光ダイオードにおいて、上記発光部と窓層との間に、窓層と接した複数個のオーミック電極を有し、該オーミック電極が発光平面の相対する角部に設置されていることを特徴とするＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体発光ダイオード。
【請求項２】オーミック電極が、発光平面の稜線に接して設けられていることを特徴とする請求項１に記載のＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体発光ダイオード。
【請求項３】各オーミック電極が、台座電極の外端部からの水平距離を等しくして配置されていることを特徴とする請求項１または２に記載のＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体発光ダイオード。
【請求項４】各オーミック電極と台座電極の外端部からの水平距離が、発光平面の1辺の長さの１／３以上であることを特徴とする請求項３に記載のＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体発光ダイオード。
【請求項５】オーミック電極の合計の底面積が、台座電極の底面積以下であることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載のＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体発光ダイオード。
【請求項６】オーミック電極の合計の底面積が、発光開放領域の面積の、２～２０％の範囲内であることを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載のＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体発光ダイオード。